

عنوان مقاله:

وابستگی دمایی اثر کاهش سد پتانسیل به وسیله درین در افزاره های CNT-FET

محل انتشار:

کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر (سال: 1394)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

محسن پرستارمیشامندانی - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت

محمد کاظم انوری فرد - عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان

حسن مسلمی - عضو هیات علمی گروه برق مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

خلاصه مقاله:

پس از کشف نانو لوله ها پیشرفت های چشم گیری از نظر مدل سازی فیزیکی و تکنولوژیکی در زمینه ترانزیستور های اثرمیدانی نانو لوله کربنی (cntfet) صورت گرفته است. در این مقاله ما به تاثیر گذاری دما بر روی افزاره هایی که از نانو لوله کربنی (cntfet) به عنوان کانال استفاده میکنند خواهیم پرداخت. تاکید ما بر اثر گذاری دما بر روی کاهش سد پتانسیل توسط درین (DIBL) که یکی از پارامتر های تعیین کننده در ترانزیستور هایی که از کانال کوتاه استفاده میکنند خواهد بود. در این مقاله همچنین به تاثیر گذاری بردار کالیرایتی بر روی دما و به دنبال آن تاثیر بر روی کاهش سد پتانسیل توسط درین پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی:

بردار کالیرایتی، دما، کاهش سد پتانسیل، نانو لوله کربنی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/461117>

